

# Cited Reference 3(Korean Laid-open Patent Publication No. 1998-35323)

Disclosed are dry-powdered, double-coated R or G phosphor particles (P) with silica (C1) and titanic-coupling (C2) for use in manufacturing a CRT screen assembly, a method of manufacturing them and a CRT comprising a screen assembly manufactured by using them. Silica below 0.5 weight % and titanic-coupling below 2 weight % are dispersed and coated on the surface of the R or G phosphor particles, which have improved chargeability and flow characteristics. The CRT comprises a screen assembly manufactured by using the silica-and-titanic-coupling coated R or G phosphor particles, thus said screen comprises picture elements of red or green color emitting phosphors with silicon below 0.5 weight % and titanium below 2 weight % dispersed and coated thereon.



공개특허득1998-035323

# (19)대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. <sup>6</sup> H01J 9/20	(11) 공개번호 록1998-035323 (43) 공개일자 1998년08월05일
(21) 출원번호	목1996-053649
(22) 출원일자	1996년 11월 13일
(71) 끊원인	오리온전기 주식회사 임김용 경상북도 구미시 공단동 165번지
(72) 민영자	박태하 경상북도 구미시 형곡동 151-10 중앙이파트 201/903 윤상열 경상묵도 구미시 황상동 확진금봉아파르 102/1402 이민수 대구광역시 동구 신천4동 499-1 코스모스아파트 2/507 배호기 경상북도 구미시 공단동 765-9
(74) 데리인	이얼
创建数字: 知器	

(54) 실리카 및 티타네이트계 커플램으로 이용 코팅된 음극선관의 건식 전자사진식 스크린 제조용 R 내지 G형광 체, 그 제조방법, 이름 사용하는 스크린 제초방법 및 이에 제조된 음극선관

22

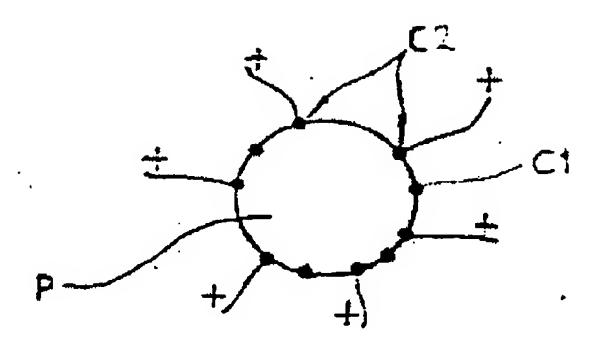
. 본 반명은 R 내지 G 형관체 분담 입자에 유용특성과 대전복성를 향상시키도록 실리카 및 티탁네이츠게 카플링은 로 분산, 이중 코팅된 R 내지 G 형관체 및 그 제조방범고 그 실리카 및 티탁늄이 잔증하는 R 내지 G 형관체로 스 크린이 구성된 윤극선관을 제공한다.

입자표면에 0.5중함% 이하의 심리카와 2중함% 이하의 티타네이트계 카플링이 분산, 코팅된 R 내지 G 형광채 분 말을 사용하여 건식전자사진식 스크린 제조방법에 의해 스크린이 제조되며, 그 경과 음극선관의 스크린은 0.5중 랑% 이하의 심리카와 2중량% 이하의 티타네이트계 카플링이 입자표면에 분산, 코팅되어 잔존하는 R 내지 G 형 광체를 포함하는 것을 뚝징으로 한다.

이에 따라, 본 발명의 R 내지 G 형광제 입자는 운용특성과 대전특성이 월등하여 마찰에 의하거나, 방전전국에 의하거나 R 내지 G 형광체 입자에 용이하게 소정의 +전하로 대전시킬 수 있는 등의 효과가 있다.

CH JE F

E (1)



#### 21/1/14

#### 医四型 乙酰胺 超图

도 1은 칼라 음극선관의 부분단면한 계략평면도,

도 2는 도 1의 물극선관의 스크린 구성을 나타낸 부분하대 단면도.

도 3 (a) 내지 (e)는 본 발명의 R 내지 G 형광체를 이용하여 움국선관의 스크린윤 제조라는 건식 전자사진식 스크린 제조공점을 개략적으로 도시한 설명도,

도 4 (a)는 스크린을 제조하기 위한 본 발명의 일에에 따른 R 내지 G 험광체 임자의 확대도이고, (b)는 스크린을 구성하는 본 발명의 일에에 따른 R 내지 G 형광체 입자의 확대표.

도 5 및 6분 R 및 G 형관체의 저항목성도.

\* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 \*

10 : 욤국선관(CRT)11 : 전자춈

12: 판벨(panel)13: 면넬(funnel)

14 : 네크(neck)15 : 양곡 보턴

16: 섀도무마스크17: 관향 요크

18 : 판별면판19a, 19b : 전자빔

20 : 현광면(스크린)21 : 빛흡수품짐

22 : 일루미늄박믹츈36 : 고로나방전장치

132 : 전도막134 : 광전도막

138 : 자외선광원140 : 자외선렌쥬

142 : 헌삼용기144a : 방전전국

144b : 노출146 : 현쥬리관 148 : 호퍼C1 : 신리가 코딩

C2 : 티탁네이트계 카폴링P : B 내지 G 형광제 입자

회원의 작사한 회의

医隐含 维拉

做器的 奔利芒 기金 製 口 是 中 逐 網 沿寶

본 반명본 음곡선관의 건식 전자시진식 스크린 제조용 R 내지 G 형광체, 그 제조방법, 이출 사용하는 스크린 제조 방법 및 이에 제조된 음곡선관에 관한 것으로, 특히 마찰 내지는 코로나 방전장치에 의한 대전육성과 유동독성물 향상시킨 실리카 및 티타네이트계 카플립의 이중 코팅의 물곡선관의 건식 전자사진식 스크린 제조용 R 내지 G 형 광체, 그 제조방법, 이룹 사용하는 스크린 제조방법 및 이에 제조된 음극선관에 관한 것이다.

일반적으로 음곡선관은, 도 1에 도시된 바와 같이, 관념(panel)(12), 편념(funnel)(13) 및 네크(14)로 구분하는 전공 벌브(bulb)와, 그 네크(14) 내부에 장착되는 전자총(11)과, 판넬(12)의 흑벽에 장착되는 새도우아스크(16)을 구비한다.

그 판넲(12)의 면판(18)의 내면에는 형광면(20)이 항성되어 있어, 전자총(11)으로부터 방출된 전자빔(19a)(19b) 은 각총 렌즈계에 의해 접속되고 가속되며, 양극 보턴(15)을 통해 인가되는 고전암에 의해 크게 가속되면서 편함 요크(17)에 의해 편합되고 새도우마스크(16)의 애퍼져 또는 습리트(16a)를 통과하여 형광면(20)에 주사된다.

형광면(20)은 면판(18)의 배면에 현성되는데, 칼라의 검우 도 2에 도시된 바와 같이 워정한 배열구조의 다수의 스트라이프(stripe) 또는 도프(dot)형상의 형관체(R.G.B)와 그 형관체들사이의 블랙코틸과 같은 빛흡수물침(21)로 형성된다. 또, 그 배면은 전도막층으로서 알뚜며늄박막층(22)이 형성되어 형광면의 취도 중대, 형광면의 이온손상방지, 청광면의 전위강하방지 등의 역할을 하게 된다. 또한, 도시되지는 않지만, 그 알뿌여늄박막층(22)의 평평도 및 반사율을 높이기 위해서는 형광면(20)과 전도막층(22)사이에 라커(lacquer)와 같은 수지가 도포된다.

이러한 형관면(20)이 발색관 인성분과 같은 형광임자들을 포함하는 현학액(slurry)또는 빛흡수물질을 포함하는 현탁액운 도포하고 건조시켜 형성되는 종래의 습식 사진 석관술(photolithographic well process)은, 고화질의 요구를 총쪽시키지 못할 뿐만 아니라 제조공정 및 제조설비가 복잡하여 제조비용이 크게 소요되며, 또한, 대량의 청정수 소모와 폐수밥생, 인배춤물, 6가 크림감관체 배춤 등 어려가지 문제점들을 안고 있다. 최근에 이러한 습식 사진식관술을 개량한 전자사진식(electropholographical) 스크린제조방법이 개발되었는데, 이 전자사진식 제조방법도 습식은 여전히 삼술한 문제점들은 안고 있으며, 건식 제조방법에 의해서는 상술한 문제점들이 상당히 해소되었다.

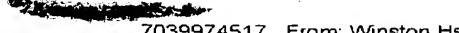
그 있예로, 본 출원인이 출원한 음극선관의 스크린 제조방법에 관하여 설명하면 다음과 같다.

도 3 (a) 내지 (e)는 상기 제조방법에 따른 각 광정은 개략적으로 도시한다. 도 3a는 면판(18)의 내면에 전도막 (132)의 그 위에 광전도막(134)이 형성되는 코팅공정이다. 전도막(132)은 예를 들면, 풀리임렉트로라이트 (polyeiectrolyle)로서 Calgon사제품인 상품명 Catfloc-c 1-50증량%와 1-50증량%의 10% PVA용액의 수용액 (나머지는 문) 문 증배의 방법으로 도표하여 간조시키므로써 형성된다. 그 위에 자외선에 반응하는 물질을 포함하는 신규한 광전도막도포용액을 도포하여 건조시킨다. 자외선에 반응하는 물질로는 비스 디메틸 페닐 디페닐 부탁트리엔(bis dimethyl phenyl diphenyl butatriene)과, 트리니트로플루오리논(trinitro-fluorenone: TNF) 및 예탈 안 트라뮈는(ethyl anthraquinone: EAQ)쯤 적어도 한가지 이상을 사용하였으며, 그 광전도막도포용액으로는 0.01 내지 10중량%의 비스 디메틸 페닐 디페닐 부탁트리앤과 고문자바인더(binder)로서 1 내지 30중량%의 물리스티 렌(polystyrene)을 진량인 동투엔(taluene)이나 크실렌(xytone)에 용해시켜 사용하였다.

도 3b는 대전공정을 개략적으로 도시한 것이다. +1K뿔트 이하, 바람직하게는 +700뿔드 이상의 직류전암을 인가하여 코코니방전경치로 대전시켰다. 광전도막(134)이 적어도 파장 450㎞ 이하의 자외선에 반당하기 때문에 암심작업이 불필요하다.

도 3c는 노광공점을 개략적으로 도시한 것으로서, 지외신광원(138)으로부터 파장이 짧고 직선성을 가진 자외선이, 자외선무과렌즈(140)를 통과하여 소명의 임사각으로 새도우마스크(16)에 입사하며, 소망의 배열을 가진 새도우마스크(16)의 애퍼차(aperture) 또는 슬리트(16a)를 통과하여 광전도막(134)을 소앙의 배열로 노광시킨다. 이 때 전도막(132)이 어스되어 있어 그 노광부분의 전하는 그 전도막(132)를 통과하여 방출된다. 그리고, 비노광부분의 전하는 그대로 광전도막(134)에 잔존하게 된다. 이 노광광정도 자외선광원(138)을 사용하기 때문에 말실에서 작업할 필요가 없다.

도 3d는 현상공정을 개략적으로 도시한다. 중래에는 이 현상공정에서 캐리어 비드와 형관체 입자 또는 빛흡수물 질입자물을 혼합하여 마찬에 의한 정전기를 대전시켰으나, 본 출원인의 발명에 의하면, 형광체 문안 또는 빛흡수 본산의 분단과 깊은 미세분말을 공기압에 의해 호퍼(148)로부터 벤츄리판(146)을 총해 코로나방전장치와 같은 방진전국(1448)과 노출(144b)을 통과시켜 본사시키므로써 그 미세분많을 대전시키고 광전도막(134)의 노광부분과 비노광부분의 어느 하나에 부착시킨다. 방전전국(144a)에 의해 미세분말에 대전되는 광전기의 국성은 상기 노광



공정에서의 노광부분과 비노광부분중 어느 부분에 그 미세분말을 뿌착시킬 것인가에 따라 결정된다. 즉 +전하품 민 비노광뿌뿐에 무착시킬 경우에는 미세분말여 "전하로 대전되고, 전하가 방충된 노광부분에 부착시킬 경우에는 미세본말이 +전하로 대천된다. 현상용기(142)로 분사된, 대진뙨 미세본맞은 전기적 인력고 반발력의 작용에 의하 여 소망의 배열로 광전도막(134)의 표면에 강하게 부착된다.

도 3e는 배이퍼 스펠링(vapour swelling)범色 이용한 분 출원인의 반명에 따른 고착(fixing)공정을 개략적으로 도 시한다. 이 고점에서는, 삼기 현상공점에서 소망의 미세분말(旨)이 소망의 배열로 부착된 광전도막(134)의 표면에 아세톤, 메림 이소부틸 케론과 같은 술벤트증기를 쪼임으로써, 적어도 광전도막(134)에 포함된 플리머물 용해시 키고, 이 용해왼 쫍리머의 접착력에 의해 전기력작용으로 부착된 미세분말(돌)을 고착시킨다. 이상에서 섞영한, 본 출원인이 출원한 율극선관의 소프린 제조방법이 설명되었는데, 그 공정 중에서 도 3d의 현상공정에서와 같이 호퍼(148)로부터 형관체 분막이 벤츄리관(146)을 개재하여 노출(144b)로 분사될 때 방전전곡(144a)에 의해 그 험광체본말을 대전시키기 위해 형광제 입자에 폴리메틸 메타크릴레이트 1차막과 중리아크릴아미드 2차약이 형성 된다. 그러나, 이러한 2차례에 검친 코팅은 번거읍고 또한, 그 플리메틸 메티크릴레이트 1차막과 폴리아크림아미 트 2차막에 의해서도 균일하고도 총분하게 대접되지 아니하며, 나아가, 방전전국(144a)를 사용하지 아니하고 마 찰에 의해 대접시킬 때에도 미국 특허 제 4.921.767호에서의 현상공정에서와 같이 형관체 입자에의 코팅어외의 마찰전기층 밑으키기 위한 캐리어 비됴(carrier bead) 등 필요로 한다는 등의 문제점이 있다. 또한, 단순히 평광제 분함에 대전투성을 부여하기 위해 줍리 메틸 데타크린레이트(PMMA)의 1차막과 풀리 아크립아미트(PAA)의 2차 막음 형성시키는 것만으로는 총분한 유통이 없어, 형광채분말간 또는 유통관이나 용기 등에 즐러붙게 되는 문제점 이 있다.

#### 발명이 이뿌고자하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 상숨한 문제점을 해결하기 위해 R 내지 G 형관체 분당 임자에 유돔목성과 대전독성을 향상시 키도둑 실리카 및 티타네이트(titenate)계 카출림(coupling)으로 분산, 이중 코팅된 유내지 G 형관체 및 그 제조방 법과 그 타타늄이 잔존하는 R 내지 G 현광체로 스크린이 구성된 움극선관을 제공하는 데에 그 목적이 있다.

#### 발명의 구성 및 착용

이러한 목적을 닮성하기 위해 본 발명은, 음국선관 판별 내면에 스크린의 제조에 사용되는 FI 내지 G형광체 임자 의 유통복성 및 대전육성을 향상시키기 위한 건식분**만 형태의 심리카 및 티타네이트계 카**끔립의 이중 코팅 R 내지 G 험광체의 제조방법에 있어서, 실리카 코팅단계가: 매탄율에 실리카를 분산시키는 1차 분산단계: 그 심리카가 분산뿐 매란음에 R 내지 G 협광체 분만을 천천히 가하는 첨가단계; 그 심리카가 분산되고 R 내지 G 협광체 분말 이 청가된 메탄율에 다시 매탄율을 본산시키는 2차 분산단계; 그 2차 분산단계의 결과물을 필터링하는 필터링단 계: 그 필터링단계에서 필터링된 결과용을 건조시키는 건조단계; 및 그 건조단계에서 건조된 결과물을 체로 걸려 실리카 코팅 R 내지 G 험광채 분말을 마련하는 시방단계를 포함하며, 그 실리카 코팅 R 내지 G 현광체 분말에 티 타네이트계 카퓸링을 코팅시키는 단계가: N~현산과 같은 유겨용제에 타타네이트게 카플링을 본산시키는 1차 분 산단계; 그 티타네이르게 카퓹링이 분산된 메탄율에 삼기 실리카 코팅 R 내자 G 형관체 분맣을 천천히 가하는 침 가단계: 그 티타네이트계 카운팅이 분산되고 B 내지 G 형광채 분임이 첨가된 메타놈에 다시 N-핵산과 같은 유기 용제를 분산시키는 2차 분산단계: 그 2차 분산단계의 결과뿐은 필터링하는 필터링단계; 그 필터링단계에서 펇터 원된 경과문을 건조시키는 건조단계: 및 그 건조단계에서 긴조된 경과용을 체로 걸러 실리카 및 티탁네이트계 카 퓰립의 이중 코팅의 R 내지 G 형광체 분말을 얻는 시방단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 몸국선판의 건식 전 자사진식 스크린 제초용 R 내지 G 형관체 제조방법을 제공한다.

상기 분산단계들이 초음파에 의해 분산되는 단계들이며, 상기 필터링단계가 끊리스 프리트 필터에 의해 필터링되 는 단계이며, 상기 건조단계는 100℃ 이하에서 3 내지 5시간정도 건조되는 단계인 것이 바람직하다.

또한 본 발명은, 음곡선판 판텔 내면에 스크린의 제조에 사용되는 건식분막 R 내지 G 형광체의 입자표면에 0.5중 향% 이하의 심리카와 2중량% 이하의 티타네이토게 카플링이 분산, 코팅된 것을 특징으로 하는 음극선판의 건식 전자사진식 스크린 제조용 B 내지 G 형광체를 제곱한다.

또, 본 발범은, 판별의 내면에 코팅된 취발성 전도막 위에 취밟성광전도막을 형성시키고, 그 광전도막에 균열한 정전하쯤 대전시킨 후, 그 광전도막을 광원으로 새도우마스크룹 용과시켜 선택적으로 노광하고, 그 노광된 부분 을 방전전국 내지는 마찰에 의해 대전된 제 1청관체로 현상시키며, 제 2 및 제 3청관체에 대해서도 각각 소앙의 예명로 상기 대전단계, 노광단계 및 현상단계활 반복하고 나서 그 형광체들을 솜벤트롭기를 쪼여 고착시키는 고착 단계를 포함하는 음극선관의 건식 전자사진식 스크린 제조방법에 있어서, 상기 현상단계에서 學입되는 제 1 내지 제 3형관체증 R 내지 G 현광체의 입자뿔이 0.5쭘량% 이하의 실리카와 2중량% 이하의 티타네이트게 카屬팅으로 분산, 코팀된 것을 특징으로 하는 음곡선관의 건식전자셔진식 스크린 제조방법을 제공한다.



또, 쩐 발명은, 0.5층량% 이하의 심리환과 2층량% 이하의 티타늄이 입자표면에 분산, 코팅된 B 내지 G 형관체를 포함하여 스크린이 형성된 것을 쪽장으로 하는 음극선관을 제공한다.

또한, 심기 코팅된 R 내지 G 형광체는 0.5중량% 이하의 실리본과 2중량% 이하의 티타늄이 합유된 율국선관을 제공한다.

이하, 도면을 참조하여 본 딸명의 바람직한 실시예를 설명한다.

도 4a에는 실리카 및 티타네이트게 가끔링의 이용 코팅 R 내지 G 형광체의 입자가 도시되며, 도 4b에는 베이킹에 의해 휘발성 물질이 연소되고 실리카 및 티타늄이 잔존하는 R 내지 G 형광체의 입자가 도시된다.

먼저, 실리카코팅 B 내지 G 형관체의 체조방법의 일실시에는 다음과 같다.

심리카 1g을 메탄을 10에 분산시킨다. 이 분산단게는 초읍파본산에 의하는 것이 바람직하다.

그 뒤 심리키가 분산된 메탄율에 1kg의 R 내지 G 험광체분맞물 천천히 가하고는 다시 0.5%의 메탄율을 본산시킨다. 어때에도 초움파에 의해 분산시킨다.

그 뒤 결과물을 글라스 프리트 필터(glass frit lilter)로 필터링하고, 그 다음 60 내지 80℃에서 2 내지 3시간 건조시킨 후 시빙(sieving) 단계로 돌어간다.

이 시방단계에서 약 400 메쉬(mesh)의 제로 걸러줌으로써 소앙의 실리카가 분산, 코팅된 R 내지 G 형광체가 얻 어진다.

이와 길이하여 얻어진 실리카 코팅 R 내지 G 형관체는 유용특성이 월등하여 R 내지 G 형관체 상호간이나 다른 뿐 집에 쉽게 뜯어붙지 아니하여 상습한 스크린 제조공정에 있어서 작업성이 뛰어나며, 또한, 스크림 최종공정인 배이킹(baking) 공정에서도 실리카가 분산, 코팅되어 있어 휘발성 물질의 제거에도 월등한다.

따라서, 베이킹 공정에서도 가열시간이나 온도쯤 짧게 할 수 있어, 형광체의 배영경계을 호토러짐이 없는 보다 바람직한 R 내지 G 형광체 배영구조를 얻을 수 있는 등 많은 효과가 있다.

도 4a에서 상숨한 바와 감이 실리카 코팅 B 내지 G 형광체입자(P)에 방전전국이나 마침에 의한 대전목섬을 향삼시키기 위하여 중래의 PMMA 2치막(PM)과 PAA 1차막(PA)대신에 티타네이트게 카플링 코팅(C)이 분산되게 형성된다. 그 티타네이트게 카플링된 소수성과 친수성 그룹북 포함하며, 그 일메로서 다음과 같은 구조식을 들 수 있다.

상기 구조식에서 스테아릴(stearyl group) 그룹( $C_{17}H_{35}$ )은 소수성 그룹이며, 이소프로폭시(isopropoxy)( $C_3H_7O$ )는 친수성 그룹으로서 삼기 티타네이트계 카플링은 그 R 내지 G 항광체임자에 본산, 코팅되어 R 내지 G 항광체임자의 금속화물 내지는 산황화물의 금속과 결합하게 된다. 즉, 삼기 구조식에서 친수성 그룹(이소프로쬭시(C

 $_{3}$ H $_{7}$ )대신에 그 자리에 R 내지 G 형광제 표면에 부착된  $\mathrm{SiO}_{2}$ 에 결합된다.

이와 같이 티타네이트게 카플림이 코팅된 P 내지 G 항관체업자는 소수성 그룹(스테아릹 그룹(C<sub>17</sub>H<sub>35</sub>)에 의해 모

4a에 도시된 바와 같이 용이하게 +로 대전된다. 그러나, 그 티타테이트계 카플링이 2중량% 이상일 때는 대전도가 떨어진다.

성술한 터타내이트계 카폴링코팅 B 내지 G 형광체의 제조방법의 일실시에는 다듬과 같다.

먼저, 티타네이트계 카플림 10g을 N-텍산과 같은 뮤기용제 14에 분산시킨다. 이 분산단계는 초음파분산에 의하는 것이 바람직하며, 그 티타네이트게 카플링으로는 상품명으로 KR TTS, KR 46B, KR 55, KR 41B, KR 38S, KR 138S, KR 238S, 338X, KR 12, KR44, KR 9SA, KR 34S 등을 들 수 있다.

그 뒤 티타네이르게 카물링이 분산된 N-핵산과 같은 유기용제의 1kg의 상습한 심리카 코벵 B 내지 G 형광체분양을 천천히 가하고는 다시 0.5분의 N-헥산과 같은 유기용제품 분산시킨다. 이때에도 초음파에 의해 분산시킨다.

그 뒤 결과들을 귤라스 프리트 필터(glass trit filter)로 필터링하고, 그 다음 60 내지 80℃에서 2 내지 3시킨 건조 시킨 후 시팅(sieving) 단계로 들어간다.

이 시넴단계에서 약 400 메쉬(mesh)의 체로 걸러줌으로써 도 4a와 같은, 소망의 실리카 및 티타네이르게 카폴링이 분산, 고팀된 R 내지 G 형광체가 얻어진다.

상술한 바와 걸이 얻어진 R 내지 G 항광체 임자들의 저항에 대하여는 그 함량에 따라 또 5 및 도 6에 도시된다. 도 5에서 티타네이트계 카플링(KRTTS)이 1중량%로 코팅된 R 형광체의 경우가 티타네이트계 카플링(KRTTS)이 0.5 중량%로 코팅된 R 형광체의 경우보다 전기 저항이 크게 나타나기 때문에 훨씬 대접목성이 양호해진다. 그러나, 2 중량%을 초과하는 경우 상술한 바와 같이 대전도가 떨어진다.

또, 도 6에서도 0.5중량% 이하의 실리카와 2충량% 전도까지의 탁타네이트계 카플링(KRTTS)이 코팀된 G 형광제의 결우 그 전기적 제항이 10

16Qcm0i상으로 대전특성이 양호하게 나타난다.

도 4b는, 도 4a의 실리키 및 타타네이트계 카쑴험의 이중 코팅 R 내지 G 형광체 입자를 상습한 스크린제조공정에 투입하여 스크린을 협성한 다음, 홈레의 방법으로 알루미늄박막충(21)을 형성한 뒤, 베이킹(beking)공정, 즉 고은 가열함으로써 전도막(132)과 광전도막(134) 및 그 타타네이트게 캬끔링의 소수성 그룹 등 휘발성 움침이 제거된 형광체입자를 도시한 것이다. 이와 같이 스크린을 구성하는 R 내지 G 형광체 입자에도 실리카(3i) 및 타타늄(Ti)이 본산, 코팅되어 진존하게 된다.

#### 粉型型 速型

이와 같이하여 얻어진 R 내지 G 형광체는 유동록성과 대전복성이 웹용하여 마찬에 의하거나, 방전전국에 의하거나 R 내지 G 형광체 입자에 용이하게 소정의 +전하로 대전시킬 수 있으며, 이에 의해 현상공점에서의 현상시간이 단축될 수 있고, 또한, 스크린 최종공정인 배이킹(baking) 공정에서도 싫리카 및 타타네이트계 카폴링이 분산, 코팅되어 있어 휘발성 물집의 체거에도 웹동하며, 제조된 스크린의 막 두께가 균일하게 될 수 있는 등의 효과가 있다.

이상에서 본 발명의 바란적한 실시에가 설명되었으나, 본 발명은 이에 한정되지 아니하고 정구범위에 기재된 사항으로부터 당업자라면 여러가지 변경과 변형이 가능하다.

#### 1577就平斜 世界

#### 성구항1

음국산판 판료 내면에 스크린의 제조에 사용되는 R 내지 G형광제 입자의 유동독성 및 대전독성을 확상시키기 위한 건식분말 형태의 심리키 및 티타네이트게 카플링 이중 코팅 R 내지 G 형광체의 제조방법에 있어서, 실리카 교병단계가:

메탄을에 심리카뿔 분산시키는 1차 분산단계;

- 그 실리카가 뿐산된 매탄올에 R 내지 G 형광체 분양을 천천히 가하는 첨가단계;
- 그 실리카가 분산되고 R 내지 G 형광체 분막이 참가된 메탄줄에 다시 예탄음을 본산시키는 2차 문산단계:
- 그 2차 본산단계의 결과품을 ভ터짐하는 필터링단계:
- 그 필터링단계에서 밑터림된 결과통을 건조시키는 건조단게; 및

第7頁,共10頁

그 건조단계에서 긴조된 결과물을 제로 걸려 심리카 코팅 FI 내지 G 형관체 분만을 마련하는 시방단계를 포함하며, 그 실리카 코팅 FI 내지 G 형관체 분만에 티타네이트계 카플링을 코팅시키는 단계가:

N-핵산과 같은 유기용제에 띄타네이트게 카플링을 분산시키는 1차 분산단계;

- 그 티타네이트게 가뿝림이 분산된 메탄음에 상기 실리카 코팅 B 내지 G 형광체 분많을 천천히 가하는 첨가단계:
- 그 티막네이트계 카플링이 분산되고 F 내지 G 형광체 분많이 참가된 메탄옾에 다시 N-엑산과 같은 유기용제를 분산시키는 2차 분산단계:
- 그 2차 분산단계의 결과뿔을 필터찢하는 필터링단계:
- 그 필터링단계에서 필터림된 결과물을 건조시키는 건조단계: 그려고
- 그 건조단계에서 건조된 결과물을 체보 걸러 싫리카 및 티타네이트계 카쮸링의 이중 코링의 R 내지 G 험광체 본 및을 얻는 시방단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 심리카 및 티타네이트계 카쮸링으로 이중 코팅된 움국선관의 건식 전자사진식 스크린 제조용 R 내지 G 형광체 제조방법.

#### 청구항2

제 (함에 있어서)

성기 본산단계들이 초음파에 의해 본산되는 단계들이며;

상기 필터링단계가 글리스 프리트 윌터에 의해 필터링되는 단계이며:

상기 긴조단계는 100℃ 이하에서 3 내지 5시간정도 긴조되는 단계인 것을 폭장으로 하는, 실리카 및 티탁네이트 게 커플링으로 이중 코팅된 음극선관의 건식 전자사진식 스크린 제조용 R 내지 G 형광체 제조방법.

#### 청구항3

음극선관 만년 내면에 스크린의 제조에 사용되는 건식분말 형광채의 입자표면에 0.5중량% 이하의 실력하와 2종량% 이하의 티타네이트계 커플링이 보산, 코팅된 것을 특징으로 하는 실리가 및 티타네이트게 커플링으로 이중 코팅된 음곡선관의 건식 전자사진식 스크린 제조용 R 내지 G 형광체.

#### 청구항4

판넬의 내면에 코팅된 휘발성 전도막 위에 휘발성광전도막을 형섬시키고, 그 광전도막에 균일한 정전하器 대전시킨 후, 그 광전도막을 광원으로 새도우마스크를 통과시켜 선택적으로 노활하고, 그 노광된 부분을 방전전극 내지는 마찰에 의해 대전된 제 1형광체로 현상시키며, 제 2 및 제 3형광체에 대해서도 각각 소망의 배멸로 상기 대전단계, 노광단계 및 현상단계를 반복하고 나서 그 형광체들을 솔벤트증기를 쪼여 고착시키는 고착단계를 포함하는 음극선관의 건식 전자시진식 스크린 제조방법에 있어서,

상가 현상단계에서 무입되는 제 1 내지 채 3형광체용 R 내지 G 현광체의 입자들이 0.5종량% 이하의 실리카와 2 충량% 이하의 티타네이트게 커플링으로 본산, 코린된 것을 특징으로 하는 음극선관의 건식전자사진식 스크린 제초방법.

#### 청구항5

실리콘과 티타늄이 입자표면에 분산, 코형된 R 내지 G 현광제를 포함하여 스크린이 형성되는 것을 특징으로 하는 급극성관.

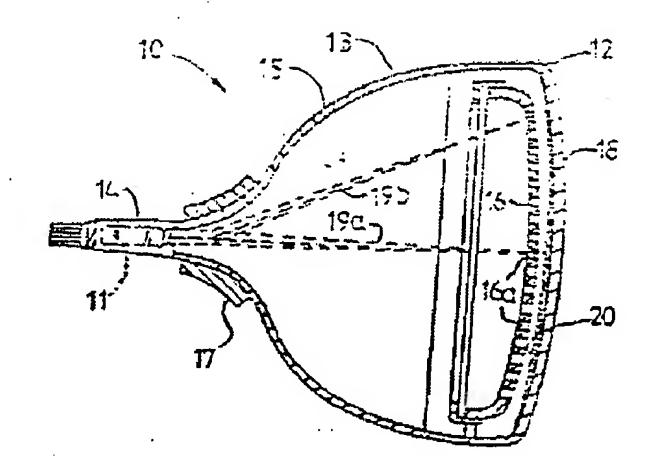
#### 성구창6

제 5항에 있어서, 상기 실리콘 0.5종량% 이하이고 심기 티타늄은 2종량% 이하면 것을 특징으로 하는 음극선관.

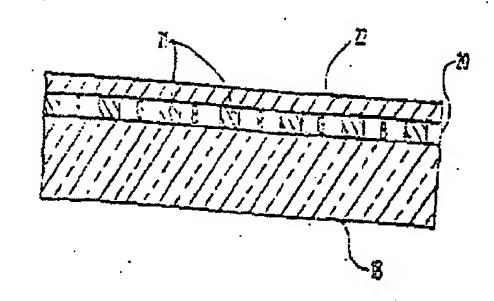
 $\Xi E$ 

SE SE!

第8頁·共10頁

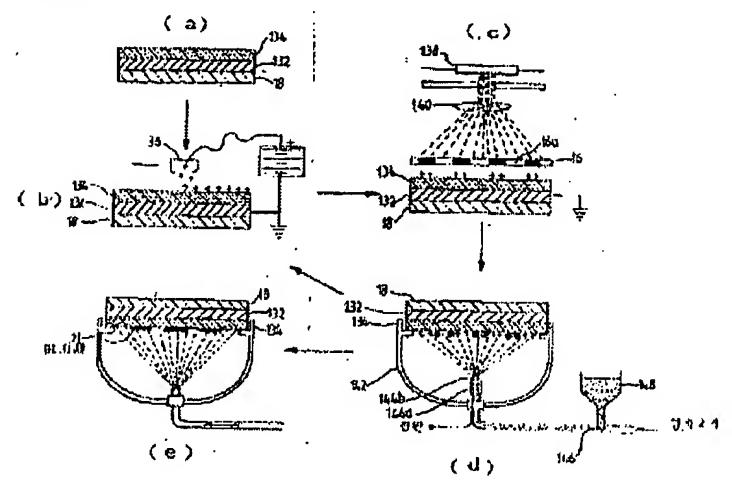






<u> 52 843</u>

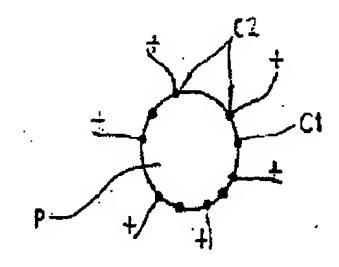
N KE

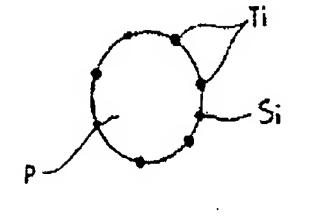


PAGE 64/66 \* RCVD AT 12/14/2006 10:04:37 PM [Eastern Standard Time] \* SVR:USPTO-EFXRF-5/8 \* DNIS:2738300 \* CSID:7039974517 \* DURATION (mm-ss):29-36

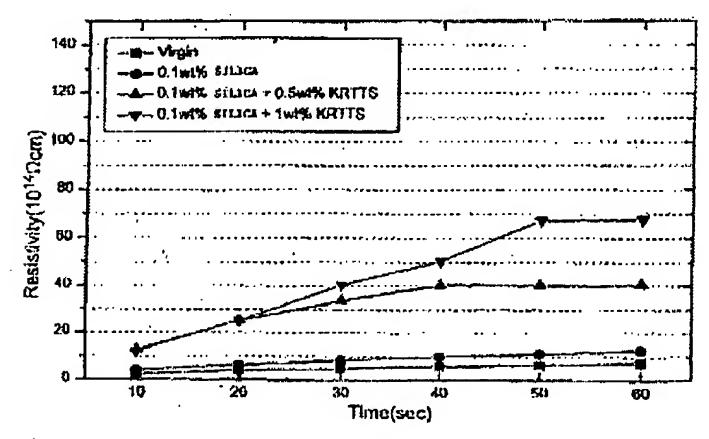
第9頁,共10頁

(b)



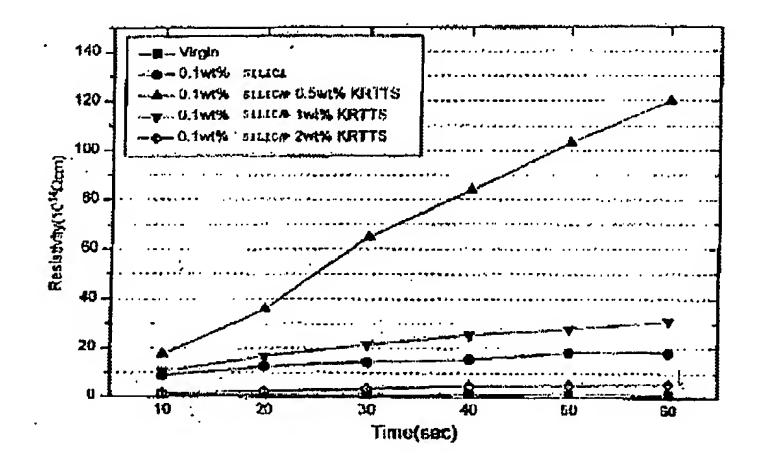


差徵5



5:76

第 10 頁·共 10 頁



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.